

REIVINDICACIONES

1. Un revestimiento óptico antirreflejante, antiestático caracterizado porque comprende:

una primera capa (16, 20) de una forma de óxido de un índice refractivo alto, transparente, dieléctrico, de un primer material;

una capa (18, 22) de una forma de óxido de un índice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, de un segundo material; y

una capa eléctricamente conductora (26) de ya sea una forma no oxidada del primer material o una forma no oxidada del segundo material interpuesta entre la primera capa y la segunda capa formada en una atmósfera inerte.

2. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la forma de óxido de índice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer material es dióxido de circonio.

3. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la forma de óxido de índice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo material es dióxido de silicio.

4. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer material es un metal de transición.

5. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer material es circonio.

6. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende una capa adhesiva (14) formada de ya sea una forma de óxido de índice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer material o una forma de óxido de índice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo material.

7. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la capa eléctricamente conductora (26) tiene un espesor en el margen de 1 a 10 nanómetros.

8. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el revestimiento óptico comprende cinco capas.

9. El revestimiento óptico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el revestimiento óptico tiene una transmitancia de 95 por ciento.

10. Unos lentes ópticos antirreflejantes, antiestáticos caracterizados porque comprenden:

un lente óptico (12);

una capa (16, 20) de una forma de óxido transparente, dieléctrico, de un metal de transición aplicado sobre una superficie del lente óptico (12);

una capa (18, 22) de una forma de óxido transparente, dieléctrico, de un metaloide aplicado sobre la superficie del lente óptico; y

una capa eléctricamente conductora (26) de una forma elemental o de aleación de una forma no oxidada del metal de transición o una forma no oxidada del metaloide aplicada sobre la capa (18, 22) de la forma de óxido transparente, dieléctrico, del metaloide.

11. Los lentes ópticos de conformidad con la reivindicación 10, caracterizados porque el lente óptico es una resina de moldeo.

12. Los lentes ópticos de conformidad con la reivindicación 10, caracterizados porque el metal de transición es circonio.

13. Un método para formar un revestimiento óptico antirreflejante, antiestático caracterizado porque comprende:

transferir un sustrato a una cámara de deposición;

formar una capa (16, 20) de una forma de óxido de un índice refractivo alto, transparente, dieléctrico, de un primer objetivo en el sustrato por deposición de pulverización reactiva en la cámara de deposición;

formar una capa (18, 22) de una forma de óxido de un índice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, de un segundo objetivo en el sustrato por deposición de pulverización reactiva en la cámara de deposición; y

formar una capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer objetivo o el segundo objetivo por deposición de pulverización no reactiva en la cámara de deposición.

14. El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado además porque comprende aplicar una capa adhesiva (14) formada de ya sea el primer objetivo o el segundo objetivo directamente en una superficie de un lente óptico (12).

15. El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado además porque comprende formar al menos un total de cinco capas.

16. El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer objetivo o el segundo objetivo comprende formar una capa de silicio.

17. El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el paso para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer objetivo o el segundo objetivo comprende formar una capa de circonio.

18. El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer objetivo o el segundo objetivo comprende formar una capa que tiene un espesor en el margen de 1 a 10 nanómetros.